

## 高性能、临界模式升压型 PFC 恒压功率开关

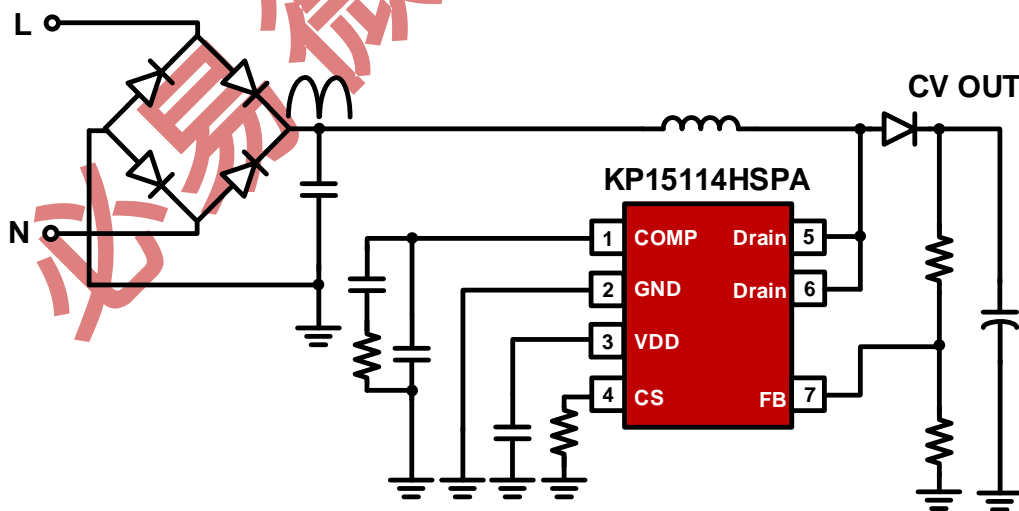
### 主要特点

- 准谐振模式高效率工作
- 支持无辅助绕组设计
- 集成高压启动和供电电路
- 集成高压 MOSFET
- 单级有源功率因数校正技术
- 全电压功率因数 >0.9, THD<10%
- 系统启动时间 <200ms
- 高精度恒压控制
- 超低工作电流
- 优异的线电压和负载调整率
- 内部保护功能:
  - 输出过压保护 (OVP)
  - 输出欠压保护 (UVP)
  - 逐周期电流限制 (OCP)
  - 前沿消隐 (LEB)
  - 过热保护 (OTP)
- 封装类型 SOP-7

### 典型应用

- 恒压 PFC 应用

### 典型应用电路



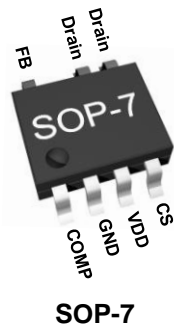
### 产品描述

KP15114HSPA 是一款高度集成的升压式 PFC 恒压功率开关，芯片采用了准谐振的工作模式，同时加以有源功率因数校正控制技术可以满足高功率因数、超低谐波失真和高效率的要求。

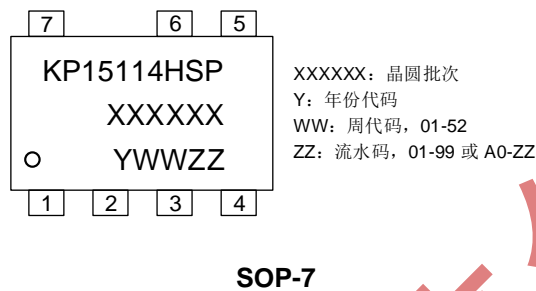
KP15114HSPA 内部集成消磁信号检测技术，同时集成有高压启动供电电路和高压 MOSFET，无需辅助绕组检测消磁和供电，只需很少的外围器件，极大的简化了系统的设计和生产成本。

KP15114HSPA 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行，如：VDD 欠压保护功能 (UVLO)、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、输出欠压保护 (UVP)等。

### 管脚封装



### 产品标记



### 管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	COMP	I	误差运放输出, 环路补偿脚
2	GND	P	芯片的参考地
3	VDD	P	芯片的供电管脚, 建议使用大于 2.2Uf 的电容作为供电电容
4	CS	I	电流采样输入管脚
5,6	DRAIN	I	内部功率 MOSFET 漏极输入管脚
7	FB	I	输出电压采样管脚, 稳态设置在 2.4V

### 订货信息

型号	描述
KP15114HSPA	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷

### 极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
DRAIN 电压	-0.3 to 600	V
VDD 直流供电电压	-0.3 to 14	V
VDD 直流箝位电流	10	mA
CS, COMP, FB 电压	-0.3 to 7	V
$P_{Dmax}$ 耗散功率 @ $T_A=50^{\circ}C$ (SOP-7), (备注 2)	0.6	W
$\theta_{JA}$ 封装热阻---结到环境(SOP-7), (备注 2)	165	$^{\circ}C/W$
芯片工作结温	150	$^{\circ}C$
储藏温度	-65 to 150	$^{\circ}C$
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	$^{\circ}C$
ESD 能力 (人体模型)	3	kV

### 推荐工作条件

参数	数值	单位
工作结温	-40 to 125	$^{\circ}C$

### 电气参数 (环境温度为 25 $^{\circ}C$ , VDD=10V, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>供电部分 (VDD 管脚)</b>						
$I_{VDD\_st}$	启动电流	$V_{DD} < V_{DD\_Op}$		300	700	$\mu A$
$I_{VDD\_Op}$	工作电流	$F_{sw}=7KHz$	80	200	350	$\mu A$
$V_{DD\_Op}$	VDD 正常工作电压		9	10	11.5	V
$V_{DD\_OFF}$	VDD 欠压保护电压		6.5	7.5	8	V
$V_{DD\_Clamp}$	VDD 箝位电压	$I(V_{DD}) = 5\text{ mA}$		14.1		V
<b>时钟控制部分</b>						
$T_{dem\_blank}$	消磁检测消隐时间	(备注 3)		2.5		$\mu s$
$T_{on\_max}$	最长导通时间		20	30	40	$\mu s$
$T_{off\_max\_st}$	启动时最长关断时间		105	150	195	$\mu s$
$T_{off\_max}$	稳态时最长关断时间		195	270	350	$\mu s$
$F_{max}$	最高工作频率			200		kHz
<b>电流采样部分 (CS 管脚)</b>						
$V_{cs\_max}$	过流保护阈值		1.8	2.0	2.2	V
$T_{D\_OC}$	过流检测延时			100		ns

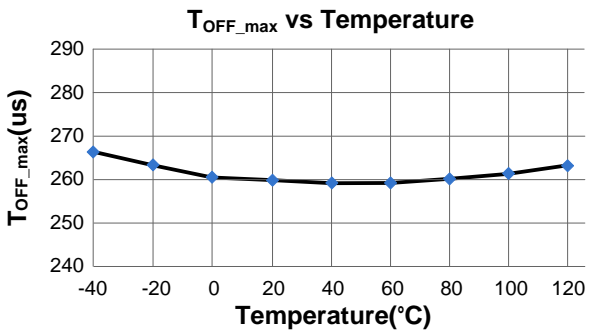
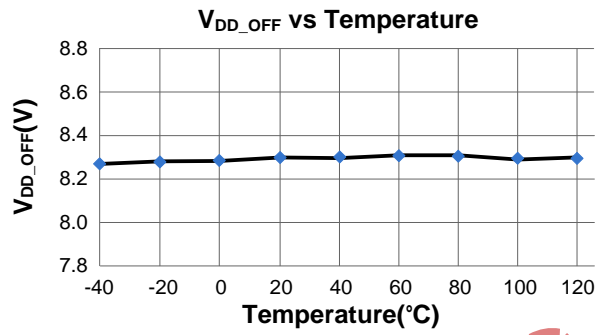
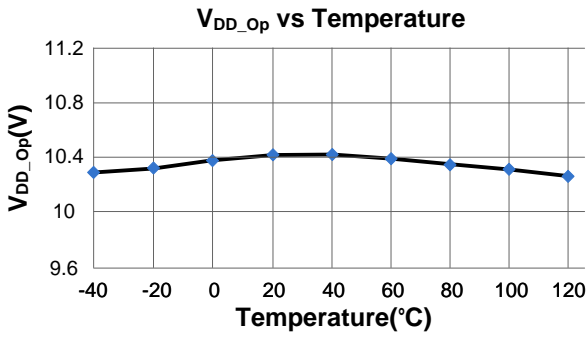
V <sub>cs_min_st</sub>	开机阶段 CS <sub>min</sub>		0.6	0.67	0.73	V
V <sub>cs_mint</sub>	稳态阶段 CS <sub>min</sub>		90	100	110	mV
<b>输出电压采样部分 (FB 管脚)</b>						
V <sub>ref</sub>	基准电压		2.35	2.4	2.45	V
V <sub>FB_OVP_EN</sub>	进入 OVP 电压	110% Ref	2.63	2.68	2.73	V
V <sub>FB_OVP_EX</sub>	退出 OVP 电压	100% Ref	2.35	2.4	2.45	V
V <sub>FB_OVP_Deb</sub>	Debounce 时间			10		us
V <sub>FB_UVP_EN</sub>	进入 UVP 电压	12% Ref	0.25	0.3	0.35	V
V <sub>FB_UVP_EX</sub>	退出 UVP 电压	12.8% Ref		0.32		V
V <sub>FB_UVP_Deb</sub>	Debounce 时间			10		us
<b>恒流补偿部分 (COMP 管脚)</b>						
V <sub>comp_H</sub>	COMP 高箝位电压			4.5		V
V <sub>comp_L</sub>	COMP 低箝位电压			1.2		V
<b>过热保护部分</b>						
T <sub>OTP_EN</sub>	过热保护阈值	(备注 3)		150		°C
T <sub>OTP_EX</sub>	OTP 恢复阈值			140		°C
<b>高压输入和 IC 供电部分 (DRAIN 管脚)</b>						
I <sub>HV</sub>	HV 充电电流	Drain =20V		10		mA
I <sub>HV_Leak</sub>	HV 漏电流		10	40	60	uA
<b>高压 MOSFET 部分</b>						
V <sub>BR</sub>	高压 MOSFET 击穿电压		600			V
R <sub>dson</sub>	导通阻抗	KP15114HSPA		2.3	2.7	Ω

**备注 1:** 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在這些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

**备注 2:** 最大耗散功率  $P_{Dmax}=(T_{Jmax}-T_A)/\theta_{JA}$ ，环境温度升高时最大耗散功率会随之降低。

**备注 3:** 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

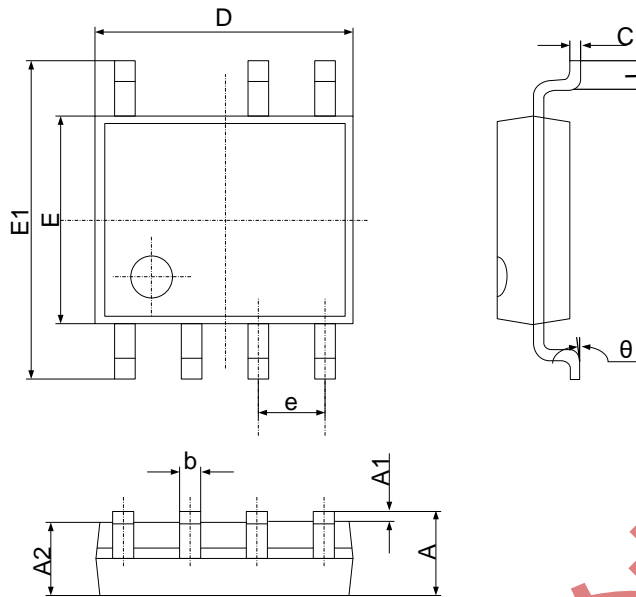
### 参数特性曲线



必易微授权立创商城

### 封装尺寸

SOP-7



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
$\theta$	0°	8°	0°	8°

### 声明

必易微确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易微的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易微不负任何法律责任。